(19) KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication

1020020063681 A

number:

(43)Date of publication of application:

05.08.2002

(21)Application

1020010004262

(71)Applicant:

BAE, JUN HYUN

number:

` ' ' ' '

BAIK, HONG KOO

(22)Date of filing: 30.01.2001

(72)Inventor:

BAE, JUN HYUN

LEE, SUNG MAN

BAIK, HONG KOO

JUNG, SANG HEON

KIM, U JIN

LEE, SEUNG JU

LEE, SUNG MAN

(51)Int. Ci

H01M 6 /18

(54) THIN FILM ELECTROLYTE AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(57) Abstract:

PURPOSE: Provided is a thin film electrolyte having at least two network former, which is excellent in cycle property and stability and has low reactivity with electrodes and long cycle lifetime. CONSTITUTION: The thin film electrolyte contains Li, P, O, X, and Y atoms, wherein one of X and Y is a substance forming a network structure, such as Si, B, S, and the other is a substance modifying the network structure, such as Ag, N, S.

And the thin film electrolyte containing Li, P, O, Si, and N is produced by forming a target giving Li, P, O, Si and then sputtering under high vacuum and N2 atmosphere.

copyright KIPO 2003

Legal Status

Date of request for an examination (20010130)

Notification date of refusal decision (00000000)

Final disposal of an application (registration)

Date of final disposal of an application (20030318)

Patent registration number (1003854850000)

Date of registration (20030515)

Number of opposition against the grant of a patent ()

Date of opposition against the grant of a patent (00000000)

Number of trial against decision to refuse ()

Date of requesting trial against decision to refuse ()

(19)-대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁷ HOIN 6/18 (11) 공개번호 특202-006368 (43) 공개일자 2012-106805일

UDIN TAID	
(21) 출원번호 (22) 출원일자	10-2001-0004262 2001년 01월 30일
(7) 출원인 (7) 출원인	백 客子
	서울 강남구 압구청2동 현대아파트 95동 202호
	미성만
	강원: 훈천지: 퇴계통. 그린타운: 168-201: 배종점
	배준현 서울특별시 동작구 사당2동 우성아파트 303동 1406호
(72) 발명자	백홍구
	서울 강남구 압구정2동 현대아파트 95동 202호
	이성만
	강원 <mark>존천시 되게 등 그린타운 (168-20)</mark> 배준현
	서울특별시 동작구 사당2동 우성아파트 303동 1406호
	이 그 그는데 경기를 되었다. 보면 보면 보다 보다 보다 보다 보다. 미승주:
	서울특별시강북구수유5동408-18
	김유진
	서울곡물시강남구삼성등4~3진홍푸론솔마파트502호
	정상헌 부산광역시금정구구서2동167-33:
(74) 대리인	박장원
살사원구 : 있음	

(54) 박막 전해질 및 그 제조 방법

23

본 발명은 리튬 이온 전도 전해질 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는, 물 이상의 네트워크 형성제를 갖는 박막 전지용 전해질 및 그 제조방법에 관한 것이다. 바람직하게는, 나구 아 사 가 즉 5 개의 원자를 할유하는 5원계 박막 전지용 전해질 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 여기서 X와 Y 중 머느하나는 네트워크의 골격을 형성하는 물질이고, 다른 하나는 네트워크의 골격을 개질시켜 그물 구조를 형성하는 물질이고, 다른 하나는 네트워크의 골격을 개질시켜 그물 구조를 형성하는 물질이다. 본 발명의 구체에에 따르면, Li-P-O 및 Li-SI-O, 즉 두 개의 네트워크 형성제를 갖고, N을 네트워크 개질제로 갖는 5원계 박막 전지용 전해질이 바람직한 결과를 제공하였다.

are:

<u>54</u>

4001

박막 전지용 전해질, 네트워크 형성재, 네트워크 개질제.

BANA

도명의 간단량 설명

도 1은 11,80, 타켓 상에 31 타켓이 모자이크된 형태를 도시한 것이다.

도 2 내지 도 3은 본 발명의 박막 전해졌에 대한 임피던스를 촉정한 결과를 도시한 것이다. 도 4는 본 발명의 박막 전해졌에 대한 전압의 함수로서의 흐르는 전류를 도시한 것이다.

도 5는 Ti,PO: Li,SiO, 복합 티켓을 미용한 박막 전해질에 대한 임피던스를 측정한 결과를 도시한 것이다.

보명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 중래기술

본 발명은 박막 전해질 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는, 를 미상의 네트워크 형성 제를 갖는 박막 전해질 및 그 제조방법에 관한 것이다.

화학적 에너지를 전기적 에너지를 변화시키는 전지는 에너지 변환 효율이 높고 간편한 구조로 인해 널리 사용되어 왔다. 그 중에서 리를 전지는 에너지 말도가 높고 높은 전위를 갖고 있음으로 인해 오늘날 전지 분야에서 가장 연구가 활발히 진행되고 있는 것 중의 해나이다. 미러한 리튬 전지는 기본적으로 음국(여: 리튬금속, 리튬 합금, 및 리튬을 탈삽입시킬 수 있는 흑연), 양국 (예: LiCob, Ligho, 및 Yob) 및 전해 절로 구성되어 있다. 그 중에서 오늘날 전지의 성능과 가장 밀접한 관계를 가지고 있는 것은 리튬 미온의 미동 통로를 제공하는 전해질이다.

리통 전지용 전해질의 예로는 액체 전해질 및 고체 전해질을 통 수 있다. 액체 전해질은 증래 리통 전지 에 널리 사용된 전해질로서, 높은 미온 전도도를 나타낸다는 장점을 가지고 있다. 그러나, 이것은 기본적 으로 산 용액으로서 환경적으로 비림적하지 못하며, 누수에 따른 위험성을 내포하고 있다는 문제점을 안 고 있다. 미러한 문제점을 해결하고자 제시된 것이 고체 전해질이며, 이것은 크게 교체고분자 전해결과 고체 육사이드 전해질로 대별할 수 있다.

고체 고분자 전해질은 폴리에틸렌옥사이드(PEO)로 미루어진 고분자 매트릭스가 리튬 미온에 대한 전도성을 갖는다는 발견에 기초하여, 현재 폴리이크릴로니트릴(PAN), 폴리비닐리덴플루오라이드(PYGF) 및 폴리비닐클로라이드(PYC) 등과 같은 다양한 조성의 고분자 전해질이 제발 중에 있다. 그러나, 미러한 고체 고분자 전해질은 기본적으로 발크 전지에 사용되는 것을 전제로 한 것으로서, 전체 전지의 크기가 수 ##대 불과한 박악 전지용 전해질로는 그 사용이 제한되어 있다.

고체 옥사이드 전해질은 새롭게 각광받고 있는 박막 전지용 전해질로서, 네트워크의 골격을 형성하는 네트워크 형성제 및 네트워크의 골격을 개질시키는 네크워크 개질제(network modifier)를 기본적으로 포함하고, 추가로 네트워크에 리튬이온의 청가량을 증진시키는 네트워크 도핑제(network dopant)를 포함할 수 있다. 이러한 고체 옥사이드 전해질의 대표적 예로는 Li-P-O-N을 구성요소로 포함하고 있는 미국특허 제5,338,625호 및 그의 분할 출원인 미국특허 제5,455,126호를 들 수 있다. 상기 '625 및 '126 특허는 네트워크 골격을 형성하는 네트워크 형성제로 Li-P-O를 갖고, 네트워크 골격의 절단, 축중합, 브랜칭 (branching) 등에 의해 네트워크의 골격을 개질시켜 그물구조를 형성하는 네크워크 개질제(network modifier)로 N을 갖고 있다.

그러나, 상기의 미국특허에도 불구하고, 교체 목사이드 전해질에 대한 개발은 아직 초기 단계에 머무르고 있으며, 다양한 형태의 고분자 옥사이드 전해질의 개발이 요청되고 있는 실정이다.

监督的 的掌卫环 强长 对金号 强和

따라서 본 발명의 목적은 새로운 고체 옥사이드 전해질을 제공하는 것이다.

본 활경의 또 다른 목적은 두 개 이상의 네트워크 형성제를 갖는 고체 전혀질을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 L1-P-0-X-Y의 5원계 교체 전해질을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 Li-P-0-Si-NPI 5원계 고체 전해질을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 상기 고체 전해질을 제조하는 방법을 제공하는 것이다.

상기한 본 발명의 목적들은 전해질 구성원소간의 불성을 제어하여 구성 성분들간의 결합력과 결합 구조를 변화시켜, 높은 리튬 이온 전도도, 낮은 전자전도도 및 구조적으로 안정한 그물구조를 형성하며 전국과 계면에서 안정한 전해질을 제공함에 의해 성취될 수 있다.

발명의 구성 및 작용

본 방명은 박막 전해질 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는, 물 이상의 네트워크 형성 제품 갖는 박막 전해질 및 그 제조방법에 관한 것이다. 비람직하게는, LT-P-0-X-Y, 즉 5개의 원자를 함유 하는 5원계 박막 전해질에 관한 것이다.

상기 X 및 Y 중 미노 해나는 네트워크의 골격을 형성하는 물질이고, 다른 하나는 네트워크의 골격을 개질 시켜 그물 구조를 형성하는 물질이다. 네트워크의 골격을 형성하는 물질의 예로는 SI, B 및 S를 볼 수 있고, 미들은 SiO, BO, GeS, AsS 등의 화합물에 의해 공급될 수 있다. 네트워크의 골격을 개질시켜 그물 구조를 형성하는 물질의 예로는 As, N 및 S를 될 수 있으며, 미들은 AgO, LIS 및 LIN 등의 화합물에 의해 공급될 수 있다.

본 발명의 구체예에는 Li, P, O, Si 및 N의 5개의 원소를 합유하는 리튬 이온 전도 전해질이 개시되어 있다. 마기서, Li, P, O, Si는 네트워크의 골격을 형성하는 물질이고, N은 네트워크의 골격을 개질시켜 그물 구조를 형성하는 물질이다. 즉, 상기 전해질은 Li P-O 및 Li-Si-O, 즉 두 개의 네트워크 형성제를 갖고, H을 네트워크 개절제로 갖는 5원계 전해질이다.

상기 박막 전해질을 제조하는 방법은 Li, P, O, Si를 제공할 수 있는 EI겐을 형성하고, 고진공 N, 분위기 하에서 스퍼터링을 수행하여 Li, P, D, Si 및 N의 5개의 원조를 참유하는 박막을 형성하는 단계를 포함한

Li, P. D. Si를 제공함 수 있는 타겠의 형성은 Li,PD, 타켓 상에 Si 또는 SiD, 모자이크 타켓을 위치시킴 에 의해, 또는 Li,PD, 및 Li,SiD,의 복합률을 합유하는 Li,PD,:Li,SiD, 복합 타켓을 형성시킴에 의해 성취 될 수 있으며, 또한 반드시 미에 한정되는 것은 아니다.

스퍼터링은 다양한 방법에 의해 수행될 수 있다. 그 예로는 N. 반응성 RF 스퍼터링, e 넴 증발기(e beam evaporator) 및 IBAD(jon beam Assisted Deposition) 등을 들 수 있다.

보 발명에 따른 전해질은 저온 공정에 의해 비정질 형태를 유지하며, 미것에 의해 높은 전하 이동제 (charge carrier) 농도, 높은 베이컨시(vacancy) 또는 통새 자리(Interst)tial site) 농도, 낮은 미온 미온 다음 활성화 에너지에 의해 높은 이온 전도도를 갖는다. 본 발명의 전해질은 또한 참가된 X 및 Y 물질이 네동 활성화 에너지에 의해 높은 이온 전도도를 갖는다. 본 발명의 전해질은 또한 참가된 X 및 Y 물질이 네동 활성화 에너지에 의해 높은 이온 전도도를 갖는다. 본 발명의 전해질은 또한 참가된 X 및 Y 물질이 네동 일 보이 구조적 안정화에 기어하여, 각 원소간의 결합력, 결합 특성, 결합의 상대적 강도, 리통 이온과 트워크의 구조적 안정화에 기어하여, 각 원소간의 결합력, 결합 특성, 결합의 상대적 강도, 리통 이온과 및 반응성을 향상시켜 구조적 및 화학적으로 안정한 특성을 나타낸다. 따라서, 상기의 전해질은 박막 전 및 반응성을 향상시켜 구조적 및 화학적으로 안정한 특성을 나타낸다. 따라서, 상기의 전해질은 박막 전 및 반응성을 향상시켜 구조적 및 화학적으로 안정한 특성을 나타낸다. 따라서, 상기의 전해질은 박막 전 및 반응성을 향상시켜 구조적 및 화학적으로 안정한 특성을 사용된다.

실시예

Dish, 아래의 실시예를 들어 본 발명의 보다 자세히 기술할 것이다. 본 발명의 범위가 이를 실시예에 한 정되는 것은 아니다.

실시에 1

박막 전해질의 제조 방법

a) Si 티켓이 모자이크 된 나 PD, 티켓 제작

Li₈PO, 분말(일본고순도화학, 순도: 99.95% 이상) 20 9을 압착하며 2 인치 디스크 형태로 제작하였다. 압 확된 디스크를 5°C/min의 증본 속도로 900°C로 중은시킨 후, 상기 온도에서 3시간 동안 열쳐리하며 Li₈PO, 타겟을 제작하였다. Si 웨이퍼를 0.7 cm ×0.7 cm 크기로 잘라 Si 타겟을 제조하고, 미것을 삼기 Li₈PO, 타겟 상에 4, 5, 및 6개 각각 위치시켜 Si 타겟이 모자미크 된 Li₈PO, 타겟을 제조하였다. 도 1은 Li₈PO, 타겟(1) 상에 Si 모자미크 타겟(2)미 5개 위치하는 경우를 도시한 것이다.

b) 박막 전해졌의 제작

햄버 내 진공을 2×10^6 torr까지 배기하고, 햄버에 N- 가스(순도: 99.9999%)를 5×10^6 보다 지원을 조절하여 햄버내의 진공이 5×10^6 torr가 유지되도록 하였다. 그 후, 스페터링 파워를 75 되도록 하고, 스페터링을 수행하는 동안 기관을 회전시키면서, RF 스페터링을 10시간 동안 실시하여, Li-P-0-SI-N을 함유하는 박악 전해질을 제작하였다.

실시에 2

이온 전도도의 측정

박막 전해질의 이온 전도도를 측정하기 위해, 실시에 1과 동일한 중착 조건 하에서, A1과 기관 상에 하부 Pt 전국, 막막 진해질, 상부 Pt 전국 순으로 순차 중착시켜 만/탁막 진해질/Pt 정태의 샌드위치 셀을 찌 작하였다. 상기와 같이 제조된 셀의 임피던스는 독일 Zahmer 사의 IBGe을 사용하였으며, 상기 셀의 DCY(Open Circuit voltage)에서 10 mV의 성동(perturbation)을 가해 IM tz부터 10 hz까지 측정하였으며, 그 결과를 도 2 내지 3대 나타내었다. 도 2는 2 인치 디스크 형태의 Li_PO, 타켓 상에 0.7 cm ×0.7 cm 크 기의 31 모자이크 타켓이 4개 위치할 때의 임피던스를 나타낸 것이고, 도 3은 2인치 디스크 형태의 Li_PO, 타켓 상대 0.7 cm ×0.7 cm 크기의 31 모자이크 타켓이 5개 위치할 때의 임피던스를 나타낸 것이다. 측정 된 상기 박막 전해질의 이온 전도도는 각각 1.8 ×10 및 2.1 ×10 이었으며, 타켓이 6개일 경우에는 1.6 ×10 8/cm 이었다 (전도도는 1/저항).

실시에 3

사용 가능한 전압 영역의 측정

실시에 2 중에서 2인치 디스크 형태의 LiePO, E켓 상에 0.7 cm x 0.7 cm 크기의 SI 모자이크 타켓을 5개 위치시켜 얻어진 박막 전해질을 포함하는 Pt/박막 전해질/Pt 형태의 샌드위치 셀을 사용하여 선형 스윌 전압법(linear sweep voltage method)으로 사용 가능한 전압 명역을 촉정하였다. Womatech 사의 출방전기 를 사용하였다. 10 ml/min의 속도로 전압을 숨압시키면서 셀에 흐르는 전류를 축정하였으며, 그 결과를 도 4에 나타내었다. 도 4에서 알 수 있는 바와 같이, 본 발명의 박막 전해질은 약 5.5 V의 최대 사용 전 압 영역을 가졌다.

실시며 4

SI 타것 대신에 SIO, 타것을 사용하는 것을 재외하고는, 실시에 1과 동일한 방법으로 박막 전해질을 제조하였다. 이러한 방식으로 제조된 박막 전해질의 이온 전도도는 약 1 ×10⁵ S/cm - 2 ×10⁵ S/cm를 나타내었으며, 최대 사용 전압도 SI 타겠과 거의 동일한 결과를 제공하였다.

Li_PD_:Li_SiO_ 복합 EI것을 이용한 박막 전해질의 제작

고순도의 Li,PO, 분말과 Li_SiO, 분말을 약 0.9-0.5:0.1-0.5 의 중량비로 혼합하며 복합물을 형성한 후, 상 기 복합물을 압착하여 2 인치 디스크 형태로 제작하였다. 압착된 디스크를 5c/min의 층은 속도로 900℃로 승은시킨 후, 상기 온도에서 3시간 동안 열차리하여 Li,PO.:Li_SiO, 복합 단켓을 제작하였다. 챔버 내 진공을 2 × 10° torr까지 배기하고, 챔버에 N. 가스(순도: 99.9999X)를 5sccm으로 넣어주면서 배기 밸브를 조절하여 챔버내의 진공이 5 × 10° torr가 유지되도록 하였다. 그 후, 스퍼터링 파워플 750가 되도록하고, 스퍼터링을 수형하는 동안 기판을 회전시키면서, NF 스퍼터링을 10시간 동안 실시하며, Li_P-0-51-N를 합유하는 박악 전해질을 제작하였다.

상기 방식으로 제조한 박막 전해질을 사용하여 미온 전도도를 측정하였으며, 그 결과를 도 3에 나타내었다. 도 5는 Li,PO,:Li,SiO, 복합 타켓을 미용한 박막 전해질의 이온 전도도가 약 5 ×10 배지 2 ×10 S/cm 정도를 갖는다는 것을 나타낸다.

상기 실시에에서 알 수 있는 비와 같이, 본 발명의 박막 전해질은 뛰어난 이온 전도도와 높은 최대 사용 전압을 갖는다. 또한, 상기 실시에는 나 구가이 되게를 포함하는 박막 전해질에 대해서 기술되어 있으나, 상 기 실시예를 다양한 네트워크 형성재 및 개질제에 적용하는 것은 본 발명이 속하는 기술 분이에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명할 것이다.

监督의 夏春

본 발명의 리튬 미온 전도 전해질은 기존의 전해질에 비해 사미를 특성 및 안청성이 우수하고, 전국과의 반응성이 낮으며, 계속적인 총방전에도 안정하며 오랜 싸이를 수명을 갖는다. 미러한 물성으로 인하여 차 세대 전지로 각광받고 있는 박막 전지 및 초소형 센서 등과 같은 여러 용용 분야에 사용될 수 있다.

또한, 본 발명의 전해질은 국내 유수 기업에서 축적된 박막 증착 기술을 용용하여 제조될 수 있음으로, 기존의 전해질이 해외로부터 제작 공정, 설비 및 기술을 미전해 음으로 발생하는 외화 유출 및 기술을 증 속화로부터 벗어날 수 있기 때문에 국익의 증대화 국내 산업의 발전 및 관련 기술의 발전과 세계적으로 개발되고 있는 박막 전자 등의 응용 분야 기술을 선점할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

(57) 경구의 벌위

청구한 1

Li, P, O, X 및 Y로 구성되는 원자를 함유하고, 상기 X 및 Y 중 어느 하나는 네트워크의 골격을 형성하는 물질이고, 다른 하나는 네트워크의 골격을 개질시켜 그물 구조를 형성하는 물질인 5원계 박막 전해질.

청구한 2

제 항에 있어서, 상기 네트워크의 골격을 형성하는 물질이 지, B 및 S로 구성되는 군에서 선택되는 것이 특징인 전해질.

청구한 3

제 1항에 있어서, 상기 네트워크의 교격을 개절시켜 그물구조를 형성하는 물질이 Å, 시 및 3로 구성되는 군에서 선택되는 것이 특징인 전해질.

청구항 4

제 항에 있어서, 네트워크의 골격을 형성하는 물질이 SI이고, 네트워크의 골격을 개절시키는 물질이 N인 것이 특징인 전해질.

청구항 5

a) Li, P, D, Si를 제공할 수 있는 티켓을 형성하고, D) 고진공 Ng 분위기 하에서 스퍼터링을 수행하여 Li, P, D, Si 및 N의 5개의 원소를 합유하는 제4형에 따른 전해질을 제조하는 방법.

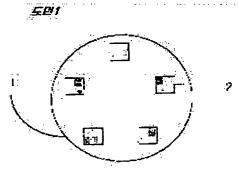
청구하 6

제5항에 있어서, Li, P, O, SI를 제공할 수 있는 타것의 형성이 Li,PD, 타것 상에 SI 또는 SIO, 모자이크 타것을 위치시킴에 의해, 또는 Li,PD, 및 Li,SiO,의 복합물을 합유하는 Li,PD,:Li,SiO, 복합 타것을 형성시 킴에 의해 성취되는 방법.

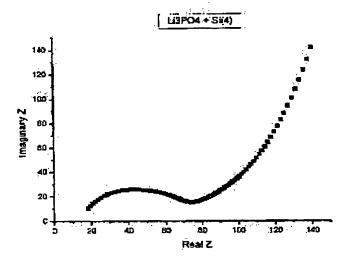
청구항 7

제 항 내지 제4항 중 마느 한 형에 따른 전혀질을 포함하는 바막 전자 또는 초소형 센서.

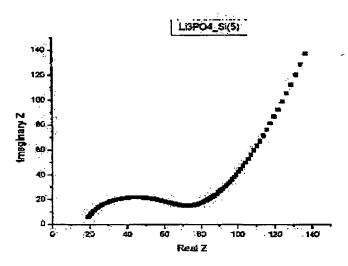
⊊₽





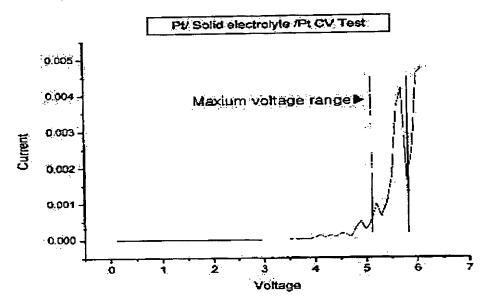






与2002-0063681





*⊊⊵*5

